

PNP/NPN エピタキシャルメサ形シリコントランジスタ—低周波電力増幅用—2SA626, 627/2SD180, 188■

絶対最大定格/Absolute Maximum Rating ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	2SA627	2SD188	単 位
コレクター・ベース間電圧	V_{CB0}	-100	100	V
コレクター・エミッター間電圧	V_{CE0}	-80	80	V
エミッター・ベース間電圧	V_{EB0}	-5	7	V
コレクター電流(直流)	$I_{C(DC)}$	-5	5	A
コレクター電流(パルス)	$I_{C(pulse)}^*$	-7	7	A
全損失($T_c=25^\circ\text{C}$)	P_T	60	60	W
ジャンクション温度	T_j	150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{sto}	-65 ~ +150	-65 ~ +150	$^\circ\text{C}$

*パルス条件: $PW \leq 10\text{ms}$, $\text{duty cycle} \leq 50\%$

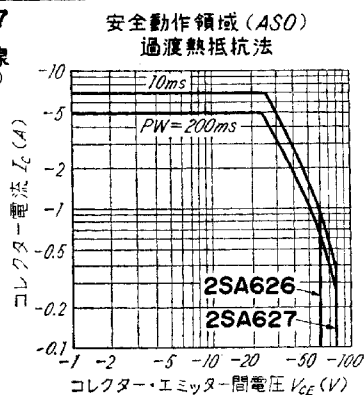
電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクター・レキ断電流	I_{CBO}	2SA626, 2SD180 $V_{CB}=60\text{V}$, $I_R=0$			2	mA
		2SA627, 2SD188 $V_{CB}=70\text{V}$, $I_R=0$				
エミッター・レキ断電流	I_{EBO}	2SA626, 2SA627 $V_{EB}=3\text{V}$, $I_C=0$			2	mA
		2SD180, 2SD188 $V_{EB}=5\text{V}$, $I_C=0$				
直流電流増幅率	h_{FE}	PNP $V_{CB}=-5\text{V}$, $I_C=-2\text{A}^*$	30	60	120	
		NPN $V_{CB}=2\text{V}$, $I_C=3\text{A}^*$				
コレクター飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5\text{A}$, $I_B=0.5\text{A}^*$			1.5	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=0.2\text{A}$		10		MHz

*パルス条件: $PW \cong 350\mu\text{s}$, $\text{duty cycle} \cong 2\%/\text{pulsed}$

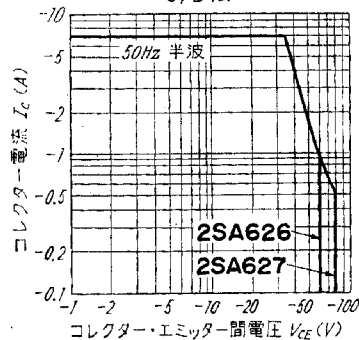
2SA627

特性曲線
($T_a=25^\circ\text{C}$)



安全動作領域(ASO)

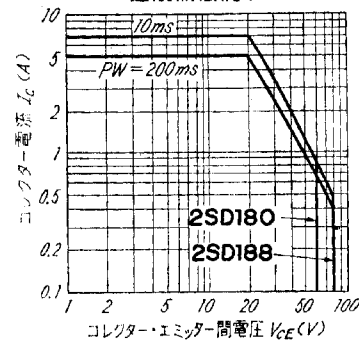
S/B法



■2SA627/2SD188 — PNP/NPN エピタキシャルメサ形シリコントランジスタ—低周波電力増幅用

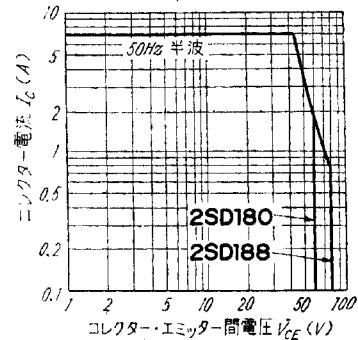
2SD188 安全動作領域(ASO)

過渡熱抵抗法

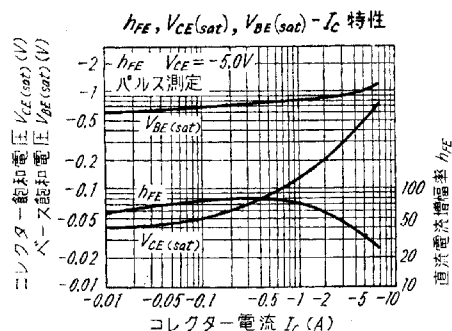


安全動作領域(ASO)

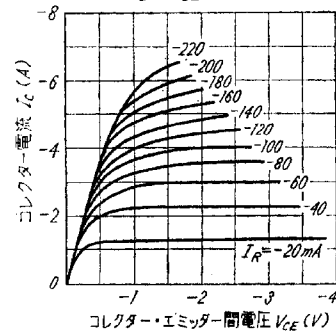
S/B法



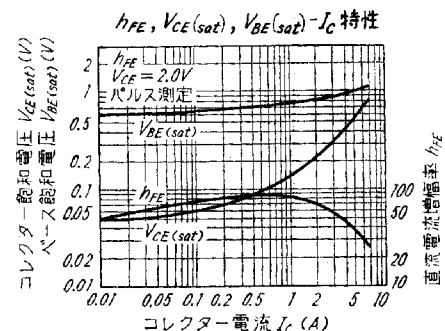
2SA627



$I_C - V_{CE}$ 特性



2SD188



$I_C - V_{CE}$ 特性

